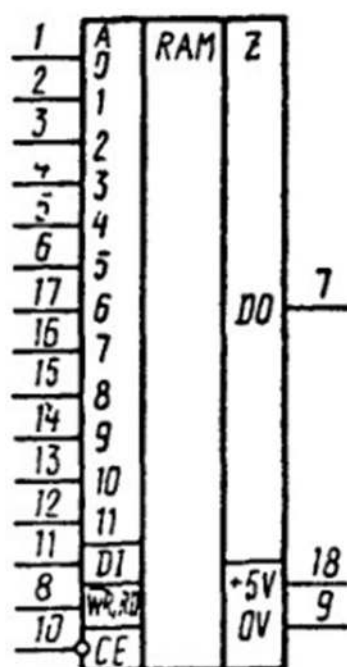


КР132РУ5, КМ132РУ5А, КМ132РУ5В

Микросхемы представляют собой статическое оперативное запоминающее устройство со схемами управления информационной емкостью 4096 бит. Содержат 26 585 интегральных элементов. Корпус типа 2104.1-18-1 и типа 2104.18-10.04, масса не более 2 г.



Условное графическое обозначение КР132РУ5, КМ132РУ5

Назначение выводов. 1 — вход адресный столбца A_0 , 2 — вход адресный строки A_1 ; 3 — вход адресный строки A_2 , 4 — вход адресный строки A_3 . 5 — вход адресный столбца A_4 , 6 — вход адресный столбца A_5 ; 7 — выход информационный D_0 , 8 — вход сигнала «запись-считывание» WR/RD ; 9 — общий $0V$; 10 — вход сигнала «выбор микросхемы»; 11 — вход информационный D_1 ; 12 — вход адресный столбца A_{11} ; 13 — вход адресный столб-

ца A10, 14 — вход адресный столбца A9; 15 — вход адресный строки, A8, 16 — вход адресный строки, A7, 17 — вход адресный строки, A6; 18 — напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Входное напряжение высокого уровня при $U_n = 4,5$ В	≥ 2,4 В
Входное напряжение низкого уровня при $U_n = 4,5$ В	< 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня при $U_n = 4,5$ В	≥ 2,4 В
Выходное напряжение низкого уровня при $U_n = 4,5$ В	< 0,4 В
Ток утечки на входе при $U_n = 5,5$ В	< 10 мкА
Ток утечки на выходе при $U_n = 5,5$ В	< 50 мкА
Ток потребления в режиме хранения при $U_n = 4,5$ В	< 30 мА
Динамический ток потребления при $U_n = 5,5$ В	< 180 мА
Время выборки адреса.	
KM132PY5A	< 85 нс
KM132PY5B	< 55 нс
Время выборки сигнала выбора микросхем	
KM132PY5A	< 85 нс
KM132PY5B	< 50 нс
Время цикла записи	
KM132PY5A	< 85 нс
KM132PY5B	< 55 нс
Время цикла считывания:	
KM132PY5A	< 85 нс
KM132PY5B	< 55 нс
Входная емкость	< 5 пФ
Выходная емкость	< 7 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5 5,5 В
Напряжение на любом выводе	-0,3 .. 5,5 В
Выходной ток низкого уровня	< 8 мА
Выходной ток высокого уровня	< 4 мА
Емкость нагрузки	< 45 пФ
Температура окружающей среды	-10. .+ 70 °С

Общие рекомендации по применению

Допустимое значение статического потенциала не более 100 В. Максимальное напряжение статической помехоустойчивости низкого уровня по всем входам 0,8 В, минимальное напряжение статической помехоустойчивости высокого уровня по всем

входам 2 В. Допускается работа при $45 \text{ пФ} < C_{\text{н}} < 600 \text{ пФ}$, при этом нормы на время выборки адреса, время выборки сигнала выбора микросхемы, время цикла считывания не гарантируются. Коэффициент объединения по выходу не более 40 с нагрузкой из трех входов ТТЛ-схем (например, К155).

Неиспользуемые в схемном решении входы необходимо подключить к источнику питания (+) или к общему выводу.

Для каждой микросхемы в непосредственной близости между выводами 18 и 8 должен быть подключен высокочастотный фильтр емкостью не более 0,1 мкФ.

Значение собственной резонансной частоты не менее 8,8 кГц.